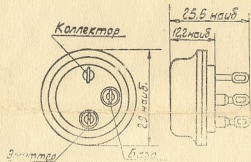


A-500



по Ге3.365.003ТУ



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

при t корпуса $+20 \pm 5^\circ\text{C}$

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РЕЖИМЫ

при t от -60°C до $+150^\circ\text{C}$ на переходе

№ п.п.	Наименование параметров	Обозначен.	Един. измер.	Знач. реж.	Прим.
1	Ток коллектора	I_k	а	3	1
2	Ток базы	I_b	а	1,5	
3	Напряжение коллектор-эмиттер при $R_{эб}=10$ ом	$U_{кэ}$	в	120	1,2
	Постоянное		в	250	1,2,3
	Импульсное		в	3	1
4	Обратное напряжение эмиттер-база	$U_{бэ}$	в	3	1
5	Мощность, рассеиваемая на коллекторе при t корпуса $0 \pm 100^\circ\text{C}$	P_k	Вт	10	1
6	Предельная температура корпуса	t кор.	$^\circ\text{C}$	100	1
7	Предельная частота		мг ц	1	1,4

- ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Не должен превышать ни один из других предельно-допустимых эксплуатационных режимов.
 2. При температуре перехода до $+100^\circ\text{C}$. При температуре перехода от 100°C до 150°C снижается линейно на 10% на каждые 10°C .
 3. При длительности не более 500 мсек и скважности ≥ 10 .
 4. Гарантируется конструкцией.

№ п.п.	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ	Обозначение	Единица измерения	Норма		Режим испытания					Схема включения
				не менее	не более	U_k	$U_{э}$	I_k	I_b	$R_{эб}$	
1	Начальный ток коллектора	$I_{кн}$	ма	3	200					10	ов
2	Обратный ток эмиттера	$I_{эо}$	ма	50		3					
3	Коэффициент усиления по току	$\beta_{ст}$		10	50	3		2,5			
4	Напряжение коллектор-эмиттер в режиме насыщения	$U_{кн}$	в	0,1	1,0			2	0,32		
5	Входное напряжение	$U_{вх}$	в	2	3			2,5			
6	Начальный ток коллектора при температуре корпуса $+100 \pm 5^\circ\text{C}$ Содержание золота—0,253 мгр. серебра—100,457 мгр.	$I_{кн}$	ма	10	200					10	

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 6 мм от корпуса транзистора. При пайке температура корпуса не должна превышать $+120^\circ\text{C}$. Пайка проводится паяльником, нагретым до температуры $250 \pm 10^\circ\text{C}$ в течение времени не более 2—3 секунд.
- В электрическую цепь, находящуюся под напряжением, базовый контакт транзистора должен присоединяться первым и отключаться последним.
- При эксплуатации транзисторов в условиях механических воздействий их необходимо крепить за корпус.
- При конструировании схем следует учитывать возможность самовозбуждения транзистора за счет паразитных обратных связей.
- За температуру корпуса принимается температура любой точки основания транзисторов.
- Крепление транзистора к теплоотводу должно обеспечивать надежный тепловой контакт.

Дата выпуска *VI* 197 г. Начальник ОТК *Иванов*